

DC ブラシレスモータドライバシリーズ

速度制御内蔵 3 ホールセンサ 三相ブラシレスモータドライバ

BM62380MUV

概要

BM62380MUV は電源電圧定格 40 V、出力電流定格 2.0 A の三相ブラシレスモータ正弦波駆動用ドライバ IC です。3 つのホールセンサによってロータ位置を検出します。また速度フィードバック制御機能を内蔵しており、入力 PWM 信号に対する回転数特性とモータから受ける回転数が合うよう出力 PWM Duty を制御します。

重要特性

- 動作電源電圧範囲: 8 V ~ 28 V
- 出力電流定格: 2.0 A
- 出力オン抵抗 (上下合計): 0.6 Ω (Typ)
- PWM 周波数: 40 kHz (Typ)
- スタンバイ電流: 0.6 mA (Typ)
- 動作温度範囲: -40 °C ~ +85 °C

特長

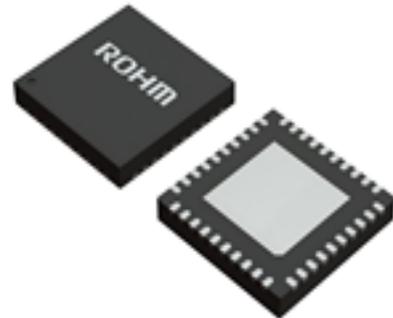
- PWM Duty 入力による速度制御
- 低 ON 抵抗 DMOS 出力
- 昇圧回路内蔵
- 3 つのホールセンサによる正弦波駆動
- 自動進角制御
- モータ極数設定機能
- ソフトスタート機能
- カレントリミット機能
- パワーセーブ機能
- 回転方向設定
- ショートブレーキ制御
- 速度フィードバック制御
- OTP 搭載により、回転数テーブルや各種パラメータを設定可能
- 各種保護機能 (モータロック保護 [MLP]、高速回転保護、過電圧保護 [OVLO]、低電圧保護 [UVLO]、過熱保護 [TSD]、過電流保護 [OCP])

パッケージ

VQFN040V6060

W (Typ) x D (Typ) x H (Max)

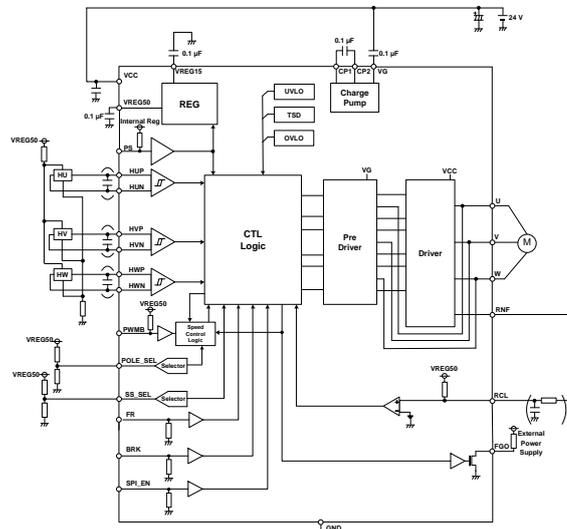
6.00 mm x 6.00 mm x 1.00 mm



用途

- ファンモータ
- その他一般民生機器

基本アプリケーション回路

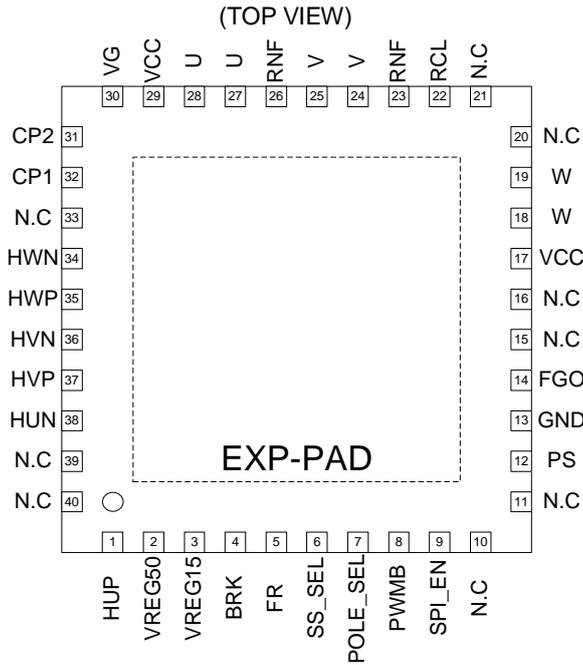


○製品構造：シリコンを主材料とした半導体集積回路 ○耐放射線設計はしていません

目次

概要.....	1
特長.....	1
用途.....	1
重要特性.....	1
パッケージ.....	1
基本アプリケーション回路.....	1
目次.....	2
端子配置図.....	3
端子説明.....	3
ブロック図.....	4
絶対最大定格.....	5
熱抵抗.....	6
推奨動作条件.....	6
電気的特性.....	7
応用回路例.....	9
基板設計留意.....	9
端子機能説明.....	10
動作説明.....	12
熱抵抗モデル.....	22
入出力等価回路図.....	23
使用上の注意.....	24
発注形名情報.....	26
標印図.....	26
外形寸法図と包装・フォーミング仕様.....	27
改訂履歴.....	28

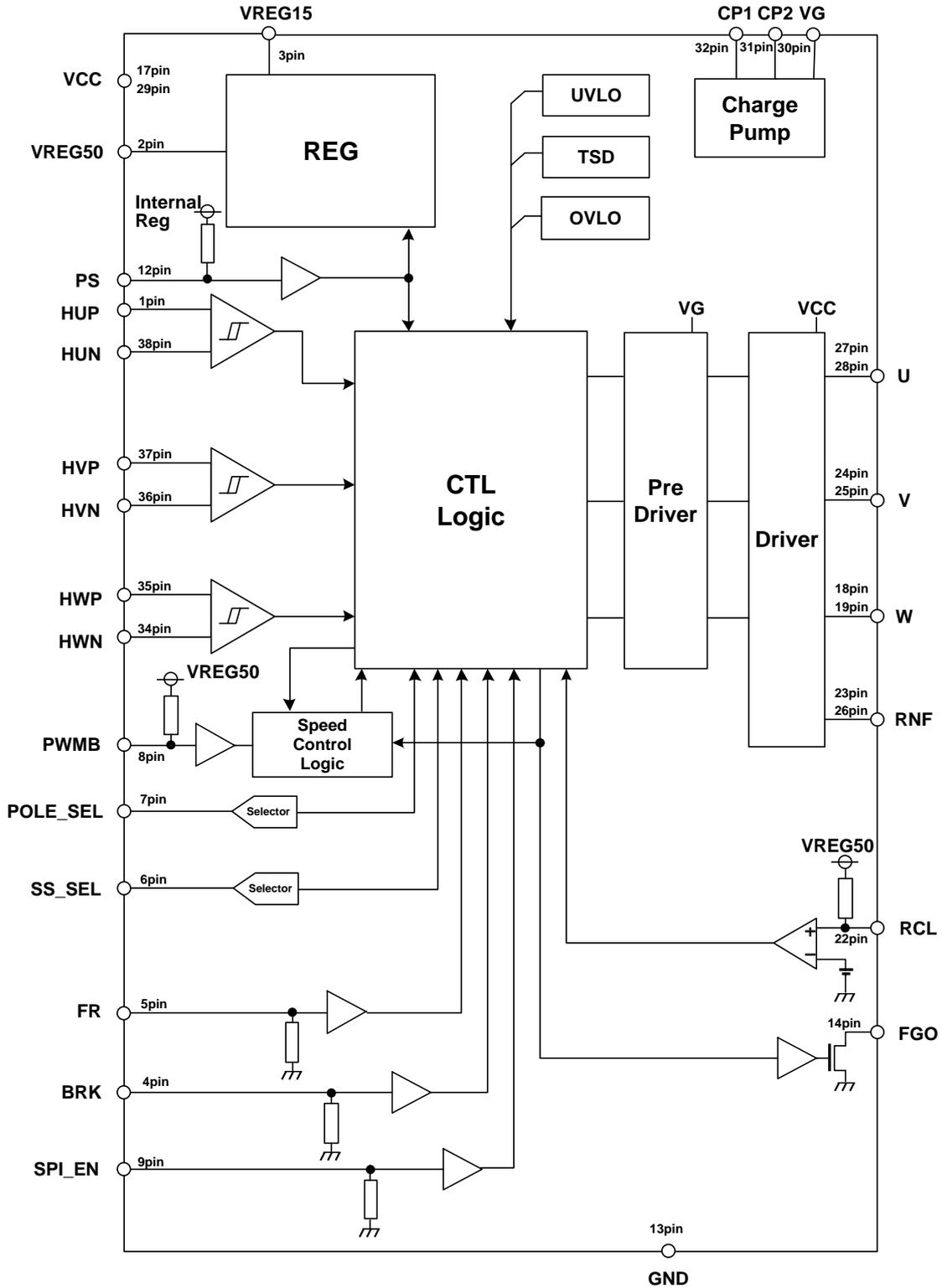
端子配置図



端子説明

端子番号	端子名	機能	端子番号	端子名	機能
1	HUP	U相ホール入力+側	21	N.C.	N.C. (Open)
2	VREG50	基準電圧出力	22	RCL	出力電流検出電圧入力
3	VREG15	ロジック回路用内部電圧出力	23	RNF	電流検出抵抗接続端子
4	BRK	ブレーキ制御 / SPI通信データ入出力	24	V	V相出力
5	FR	回転方向設定	25	V	V相出力
6	SS_SEL	ソフトスタート設定	26	RNF	電流検出抵抗接続端子
7	POLE_SEL	モータ極数設定	27	U	U相出力
8	PWMB	PWM入力 (負論理) / SPI通信クロック入力	28	U	U相出力
9	SPI_EN	SPI通信設定	29	VCC	電源
10	N.C.	N.C.(Open)	30	VG	昇圧出力
11	N.C.	N.C.(Open)	31	CP2	昇圧用コンデンサ接続 2
12	PS	パワーセーブ入力	32	CP1	昇圧用コンデンサ接続 1
13	GND	グラウンド	33	N.C.	N.C. (Open)
14	FGO	回転数パルス信号出力	34	HWN	W相ホール入力ー側
15	N.C.	N.C. (Open)	35	HWP	W相ホール入力+側
16	N.C.	N.C. (Open)	36	HVN	V相ホール入力ー側
17	VCC	電源	37	HVP	V相ホール入力+側
18	W	W相出力	38	HUN	U相ホール入力ー側
19	W	W相出力	39	N.C.	N.C. (Open)
20	N.C.	N.C. (Open)	40	N.C.	N.C. (Open)
裏面	EXP-PAD	EXP-PAD は、GND に接続してください			

ブロック図



絶対最大定格 (Ta= 25 °C)

項目	記号	定格	単位
電源電圧 (VCC)	V _{CC}	40	V
VG 電圧	V _G	40	V
ドライバ出力電流 (U、V、W)	I _{OMAX}	2.0	A
ドライバ出力電圧 (U、V、W)	V _{OMAX}	40	V
RNF 端子電圧	V _{RNF}	0.7	V
FGO 端子電圧	V _{FGO}	30	V
FGO 端子電流	I _{FGO}	10	mA
VREG50 端子電流	I _{VREG50}	-30	mA
RCL 端子電圧	V _{RCL}	4.5	V
制御入力端子電圧 (Note 1)	V _{IN1}	7	V
ホール入力端子電圧 (Note 2)	V _{IN2}	7	V
最高接合部温度	T _{jmax}	150	°C
保存温度範囲	T _{stg}	-55 ~ +150	°C

注意 1: 印加電圧及び動作温度範囲などの絶対最大定格を超えた場合は、劣化または破壊に至る可能性があります。また、ショートモードもしくはオープンモードなど、破壊状態を想定できません。絶対最大定格を超えるような特殊モードが想定される場合、ヒューズなど物理的な安全対策を施していただくようご検討をお願いします。

注意 2: 最高接合部温度を超えるようなご使用をされますと、チップ温度上昇により、IC 本来の性質を悪化させることにつながります。最高接合部温度を超える場合は基板サイズを大きくする、放熱用銅箔面積を大きくする、放熱板を使用するなど、最高接合部温度を超えないよう熱抵抗にご配慮ください。

(Note 1) SS_SEL、POLE_SEL、PWMB、PS、BRK、FR、SPI_EN 端子。

(Note 2) HUP、HUN、HVP、HVN、HWP、HWN 端子。

熱抵抗(Notes 3)

項目	記号	熱抵抗(Typ)		単位
		1層基板(Notes 5)	4層基板(Notes 6)	
VQFN040V6060				
ジャンクション—周囲温度間熱抵抗	θ_{JA}	101.4	23.7	°C/W
ジャンクション—パッケージ上面中心間熱特性パラメータ(Notes 4)	Ψ_{JT}	5.0	3.0	°C/W

(Notes 3) JESD51-2A(Still-Air)に準拠。

(Notes 4) ジャンクションからパッケージ(モールド部分)上面中心までの熱特性パラメータ。

(Notes 5) JESD51-3に準拠した基板を使用。

(Notes 6) JESD51-5,7に準拠した基板を使用。

測定基板	基板材	基板寸法
1層	FR-4	114.3 mm x 76.2 mm x 1.57 mmt

1層目(表面)銅箔	
銅箔パターン	銅箔厚
実装ランドパターン +電極引出し用配線	70 μ m

測定基板	基板材	基板寸法	サーマルビア(Notes 7)	
			ピッチ	直径
4層	FR-4	114.3 mm x 76.2 mm x 1.6 mmt	1.20 mm	Φ 0.30 mm

1層目(表面)銅箔		2層目、3層目(内層)銅箔		4層目(裏面)銅箔	
銅箔パターン	銅箔厚	銅箔パターン	銅箔厚	銅箔パターン	銅箔厚
実装ランドパターン +電極引出し用配線	70 μ m	74.2 mm \square (正方形)	35 μ m	74.2 mm \square (正方形)	70 μ m

(Notes 7) 貫通ビア。全層の銅箔と接続する。配置はランドパターンに従う。

推奨動作条件

項目	記号	最小	標準	最大	単位
動作温度	Topr	-40	+25	+85	°C
動作電源電圧(VCC)	V _{CC}	8.0	24.0	28.0	V
制御入力端子電圧(Notes 8)	V _{IN1}	0	-	V _{VREG50}	V

(Notes 8) SS_SEL、POLE_SEL、PWMB、BRK、FR、SPI_EN 端子。

電气的特性 (特に指定のない限り $V_{CC}=24\text{ V}$ $T_a=25\text{ }^\circ\text{C}$)

項目	記号	最小	標準	最大	単位	条件
<全体>						
回路電流	I_{CC}	-	14	28	mA	PS=0 V
スタンバイ電流	I_{STBY}	-	0.6	1.2	mA	PS=5 V
VREG50 電圧	V_{VREG50}	4.5	5.0	5.5	V	$I_{OUT}=-10\text{ mA}$
VREG15 電圧	V_{VREG15}	1.35	1.50	1.65	V	
<昇圧回路>						
VG 電圧	V_G	$V_{CC}+4.5$	$V_{CC}+5.5$	$V_{CC}+6.5$	V	
<ドライバ出力>						
出力オン抵抗	R_{ON}	-	0.6	0.9	Ω	$I_{OUT}=\pm 1.0\text{ A}$ (上下合計)
出力 PWM 周波数	f_{PWM}	36	40	44	kHz	
<ホール入力>						
入力バイアス電流	I_{HALL}	-2.0	-0.1	+2.0	μA	HUP=0 V、HUN=0 V HVP=0 V、HVN=0 V HWP=0 V、HWN=0 V
同相入力電圧範囲	V_{HALLCM}	0	-	$V_{VREG50}-1.7$	V	
入力電圧範囲	$V_{HALLRNG}$	0	-	V_{VREG50}	V	
最小入力電圧	$V_{HALLMIN}$	50	-	-	mV _{P-P}	
ホール入力ヒステレシス+	V_{HYSP}	2	12	22	mV	
ホール入力ヒステレシス-	V_{HYSN}	-22	-12	-2	mV	
<PS>						
入力電流	I_{PS}	-82.5	-55.0	-27.5	μA	PS=0 V
入力 High 電圧	V_{STBY}	3.8	-	5.0	V	パワーセーブ
入力 Low 電圧	V_{ENA}	0	-	0.5	V	駆動
<FR>						
入力電流	I_{FR}	25	50	75	μA	FR= V_{VREG50}
入力 High 電圧	V_{FRH}	$V_{VREG50}-1.2$	-	V_{VREG50}	V	U→V→W
入力 Low 電圧	V_{FRL}	0	-	0.8	V	U→W→V
<BRK>						
入力電流	I_{BRK}	25	50	75	μA	BRK= V_{VREG50}
入力 High 電圧	V_{BRKH}	$V_{VREG50}-1.2$	-	V_{VREG50}	V	ショートブレーキ
入力 Low 電圧	V_{BRKL}	0	-	0.8	V	駆動
<SPI_EN>						
入力 High 電圧	V_{SPL_ENH}	$V_{VREG50}-1.0$	-	V_{VREG50}	V	OTP 書き込みモード
入力 Low 電圧	V_{SPL_ENL}	0	-	0.8	V	駆動モード

電流項目については IC への電流流入を正表記、IC からの電流流出を負表記とする。

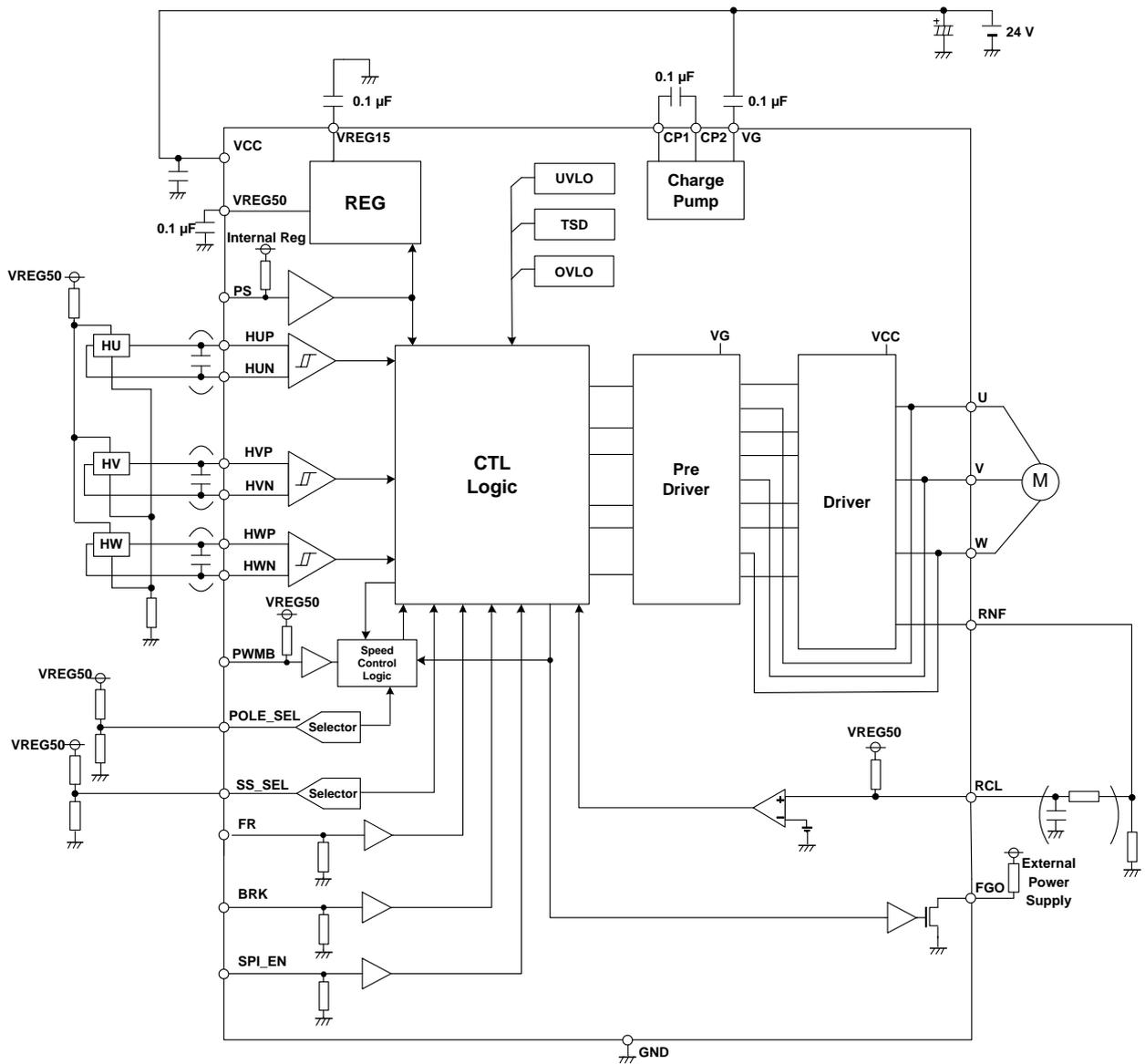
電气的特性 — 続き (特に指定のない限り $V_{CC}=24\text{ V}$ $T_a=25\text{ }^\circ\text{C}$)

項目	記号	最小	標準	最大	単位	条件
<制御入力: SS_SEL、POLE_SEL>						
入力電流	I_{IN}	-1.2	-	+1.2	μA	
<速度指令: PWMB>						
入力電流	I_{PWMB}	-75	-50	-25	μA	PWMB=0 V
入力 High 電圧	V_{PWMBH}	$V_{VREG50}-1.2$	-	V_{VREG50}	V	
入力 Low 電圧	V_{PWMBL}	0	-	0.8	V	
入力周波数範囲	f_{PWMB}	1	-	50	kHz	
<FGO 出力>						
出力 Low 電圧	V_{FGOL}	0	0.1	0.3	V	$I_{FGO}=+3\text{ mA}$
出力リーク電流	I_{FGLEAK}	-	-	1	μA	FGO=30 V
<カレントリミット: RCL>						
入力電流	I_{RCL}	-70	-40	-20	μA	RCL=0 V
カレントリミット検出電圧	V_{CL}	0.18	0.20	0.22	V	
<UVLO>						
VCC UVLO リリース電圧	V_{UVH}	6.5	7.0	7.5	V	
VCC UVLO ロックアウト電圧	V_{UVL}	5.5	6.0	6.5	V	
VG UVLO 電圧	V_{UVVG}	$V_{CC}+2.0$	$V_{CC}+3.0$	$V_{CC}+4.0$	V	
<OVLO>						
OVLO リリース電圧	V_{OVL}	28.5	30.0	31.5	V	
OVLO ロックアウト電圧	V_{OVH}	29.5	31.0	32.5	V	
<モータロック保護、各種保護>						
モータロック保護検出時間	t_{LK_DET}	0.45	0.50	0.55	s	
保護時間	t_{LK_PRT}	4.5	5.0	5.5	s	各種保護 ^(Note 9)

電流項目については IC への電流流入を正表記、IC からの電流流出を負表記とする。

(Note 9) モータロック保護(MLP)、高速回転保護、過電圧保護(OVLO)、過熱保護(TSD)、過電流保護(OCP)

応用回路例



基板設計留意

1. ICの電源、ICのグラウンド、モータ出力、モータグラウンド (RNF)配線はできるかぎり太くしてください。
2. ICのグラウンド配線はPCB基板のグラウンドコネクタ近くに位置してください。
3. VCC端子に付けるバイパスコンデンサはできるかぎりVCC端子の近くに配置してください。

端子機能説明

1. 電源端子 (VCC)
 - 広帯域で電源のインピーダンスを下げる目的から、電解コンデンサと並列に 0.01 μF ~ 0.1 μF 程度のセラミック・コンデンサを配置してください。
 - モータの逆起電力や PWM スイッチングノイズなどで V_{CC} が大きく振れる可能性がある場合は、バイパスコンデンサを極力端子近くに必ず配置し、 V_{CC} 電圧が安定するように調整してください。大電流使用時や逆起電力の大きいモータを使用される際には、必要に応じてコンデンサの容量を追加してください。 V_{CC} 電圧が絶対最大定格を超えることのないようにご注意ください。絶対最大定格を超えない程度のツェナーダイオードをつけることも有効です。また、VCC 端子と GND 端子に逆電圧が印加された場合も、IC が破壊に至る恐れがありますのでご注意ください。
2. グラウンド端子 (GND)

スイッチング電流によるノイズの低減や内部の基準電圧安定化のために、この端子からの配線インピーダンスはできるだけ低くし、いかなる動作状態においても最低電位になるようにしてください。また、他の GND パターンと共通インピーダンスを持たないようにしてください。
3. 昇圧端子 (CP1, CP2, VG)

上側出力 FET の駆動用に昇圧回路を内蔵しており、CP1-CP2 端子間、及び VG-VCC 端子間にコンデンサを接続することにより、 $V_{\text{CC}}+5.5\text{ V}$ (Typ) の昇圧電圧が VG 端子に発生します。接続する各コンデンサは 0.1 μF 以上を推奨します。
4. ドライバ出力端子 (U, V, W)

ドライバ出力が同期整流 PWM 動作時等で "Low" \rightarrow "High" もしくは "High" \rightarrow "Low" に切り替わるとき、出力上下 MOS の同時 ON を防ぐため、デッドタイム(0.1 μs [Typ])を設けております。
ドライバ出力を使用するうえで以下の点にごご注意ください。

 - モータの駆動電流が流れるため、太く短い低インピーダンス配線にしてください。
 - 定格以上のサージなどの急峻なパルス信号や電圧が印加されると、破壊に至る恐れがあります。定格は絶対に超えないでください。
 - 大電流使用時などドライバ出力が大きく正や負に振れる (例えば逆起電圧などが大きい場合) ことによって誤動作や破壊に至る場合には、ドライバ出力端子にショットキーダイオードを追加してください。スイッチング電流によるノイズの低減や IC 内部の基準電圧安定化のために、この端子からの配線インピーダンスはできるだけ低くし、いかなる動作状態においても最低電位になるようにしてください。また、他の GND パターンと共通インピーダンスを持たないようにパターン設計をしてください。
5. レギュレータ出力端子 (VREG50, VREG15)

VREG50 端子は 5 V (Typ) の基準電圧出力、VREG15 端子は 1.5 V (Typ) の IC 内部のロジック回路用電源です。VREG50 端子と VREG15 端子にはそれぞれ 0.1 μF ~ 1 μF 程度のコンデンサを接続することを推奨します。VREG50 端子をホール素子のバイアス用電源などに使用される際は、VREG50 端子からの流出電流が絶対最大定格を超えることのないようにご注意ください。なお、VREG15 端子はコンデンサ以外何も接続しないでください。
6. パワーセーブ端子 (PS)

PS 端子にて各相出力の ON/OFF の制御が可能です。パワーセーブ状態は他の制御入力信号よりも優先され、レギュレータ出力 (VREG50, VREG15) が OFF します。なお、PS 端子は 101 k Ω (Typ) の抵抗で内部電源にプルアップされています。

Table 1. PS 端子設定表

PS 端子設定	機能
Low	駆動
High / Open	パワーセーブ
7. モータ極数設定端子 (POLE_SEL)

モータ極数設定を行うことが可能です。VREG50 電圧 (5 V [Typ]) からの抵抗分圧により設定します。なお、設定には精度を必要とするため、5 % 以下の精度の抵抗を使用してください。モータ極数設定方法につきましては P.17 を参照してください。
8. ソフトスタート時間設定端子 (SS_SEL)

SS_SEL 端子はソフトスタートのステップ時間を調整できます。VREG50 電圧 (5 V [Typ]) からの抵抗分圧により設定します。なお、設定には精度を必要とするため、1 % 以下の精度の抵抗を使用してください。ソフトスタート時間設定方法につきましては P.16 を参照してください。
9. 速度指令入力端子 (PWMB)

PWMB 端子に入力する PWM 信号の Duty で速度制御することが可能です (負論理)。また PWMB 端子は 100 k Ω (Typ) の抵抗で VREG50 にプルアップされています。本製品の速度フィードバック制御の回転数設定につきましては P.19 を参照してください。

端子機能説明 — 続き

10. ホール入力端子 (HUP、HUN、HVP、HVN、HWP、HWN)
- ホールコンパレータにはノイズによる誤動作を防止するため、ヒステリシス ($\pm 12\text{ mV}$ [Typ]) を設けております。
 - ホール素子を使用する場合、ホール入力電圧振幅は最小入力電圧 (V_{HALLMIN}) 以上になるよう、ホール素子へのバイアス電流を設定してください。なお、ホールコンパレータの差動入力端子間には、 $100\text{ pF} \sim 0.01\text{ }\mu\text{F}$ 程度のセラミック・コンデンサを接続することを推奨します。また、ホールコンパレータには同相入力電圧範囲 (V_{HALLCM}) が設けられていますので、ホール素子にバイアスする場合はこの範囲内になるように設定してください。
 - ホール IC を使用する場合、HUP 端子、HVP 端子、HWP 端子はホール IC の出力に接続し、入力電圧範囲内 (V_{HALLRNG}) で入力してください。ホール IC の出力がオープンドレインの場合は、VREG50 電圧に外付け抵抗でプルアップしてください。HUN 端子、HVN 端子、HWN 端子には、同相入力電圧範囲内 (V_{HALLCM}) の基準電圧を入力してください (例えば VREG50 電圧から 1/2 の分圧を入力)。
11. 出力電流検出用抵抗接続端子 (RNF)
- 電流検出用抵抗 $0.12\text{ }\Omega \sim 0.50\text{ }\Omega$ を対 GND 間に挿入してください。電流検出用抵抗の消費電力 $I_{\text{OUT}}^2 \cdot R[\text{W}]$ が抵抗の定格電力を超えないように抵抗値を決定してください。また、RNF 端子から電流検出用抵抗を介して GND へのパターンはモータの駆動電流が流れるため、低インピーダンス配線にし、他の GND パターンと共通インピーダンスを持たないようにしてください。RNF 電圧が定格 (0.7 V) を超えてしまう場合、回路の誤動作などの可能性があるため、定格は絶対に超えないようにしてください。RNF 端子が GND にショートされた場合、正常な電流制限動作ができずに大電流が流れ、OCP もしくは TSD が動作する恐れがありますのでご注意ください。
12. 出力電流検出端子 (RCL)
- 電流検出コンパレータの入力端子である RCL 端子を設けております。ノイズの飛び込みなどの少ない配線を考慮してパターン設計してください。RCL 端子は $250\text{ k}\Omega$ (Typ) の抵抗で VREG50 にプルアップされています。なお、RCL 端子は GND にショートされた場合、正常な電流制限動作ができずに大電流が流れ、OCP もしくは TSD が動作する恐れがありますのでご注意ください。
13. FG 出力端子 (FGO)
- ホール信号から合成された FG 信号が FGO 端子から出力されます。パワーセーブ状態のときは出力されません。なお FGO 端子はオープンドレイン出力のため、外部にて $10\text{ k}\Omega \sim 100\text{ k}\Omega$ 程度の抵抗でプルアップしてご使用ください。また、その際には FGO 電圧及び電流が絶対最大定格を超えることのないようにご注意ください。
14. SPI 通信設定端子 (SPI_EN)
- SPI_EN 端子は VREG50 へ接続することにより BRK 端子、PWMB 端子を SPI 通信用端子に切替えることができます。SPI 通信を使用した OTP Write 動作のアプリケーション回路につきましてはアプリケーションノートを参照してください。なお、SPI 通信を使用しない場合は、SPI_EN 端子を GND に接続してください。SPI_EN 端子は $61.5\text{ k}\Omega$ (Typ) の抵抗でプルダウンされています。
15. 回転方向設定端子 (FR)
- FR 端子で回転方向切替えを行うことが可能です。FR が High で $U \rightarrow V \rightarrow W$ となり、FR が Low もしくは Open で $U \rightarrow W \rightarrow V$ となります。モータ回転中の通電順番の切替えは推奨しませんが、回転中に切替えた場合、 500 rpm 以下になるまでショートブレーキモードに移行します。FR 端子は $100\text{ k}\Omega$ (Typ) の抵抗でプルダウンされています。

Table 2. FR 端子設定表

FR 端子設定	機能
Low / Open	$U \rightarrow W \rightarrow V$
High	$U \rightarrow V \rightarrow W$

16. ブレーキ制御端子 (BRK)
- BRK 端子にて回転を停止させることが可能です。BRK が High でショートブレーキ動作になり、各相の出力は Low になります。BRK が Low もしくは Open でショートブレーキ動作を解除します。BRK 端子は $100\text{ k}\Omega$ (Typ) の抵抗でプルダウンされています。
 - ショートブレーキは保護機能よりも優先順位が高いため、保護動作中にショートブレーキ動作をさせると、保護動作は解除され、ショートブレーキ動作が有効になります。

Table 3. BRK 端子設定表

BRK 端子設定	機能
Low / Open	駆動
High	ショートブレーキ

17. ノンコネクション端子 (N.C.)
- IC 内部回路とは電氣的に接続されていません。

動作説明

1. タイミングチャート

3つのホールセンサによってロータ位置を検出します。また、出力電流を正弦波形にすることにより静音・低振動を実現しています。

1.1 3ホールセンサによる正弦波駆動のタイミングチャート

3ホールセンサ信号と出力信号のタイミングチャートを下図に示します。

FR=High (U→V→W、進角0°時)

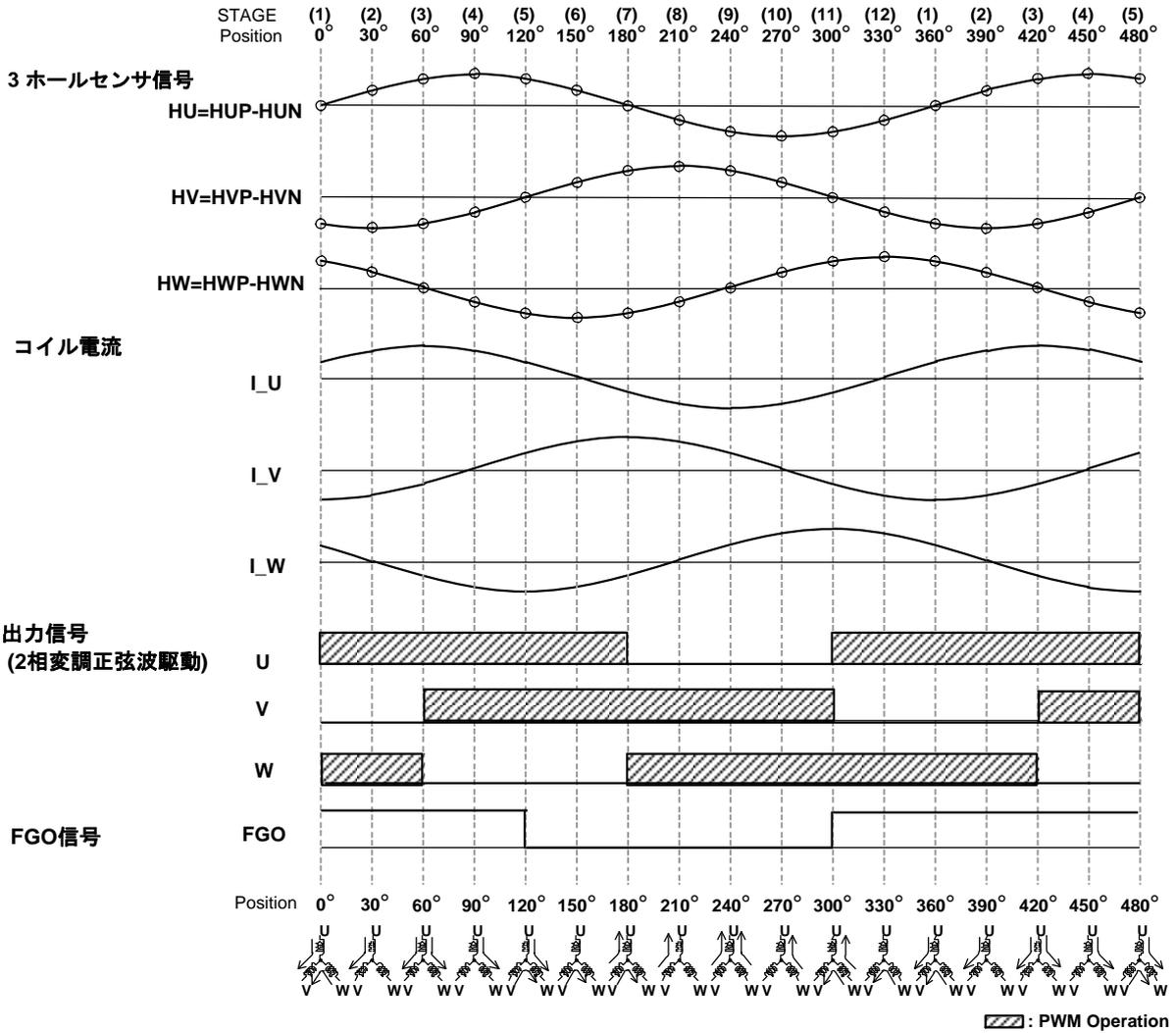


Figure 1. 正弦波駆動タイミングチャート (FR=High)

1.1 3ホールセンサによる正弦波駆動のタイミングチャート — 続き

FR=Low (U→W→V、進角 0°時)

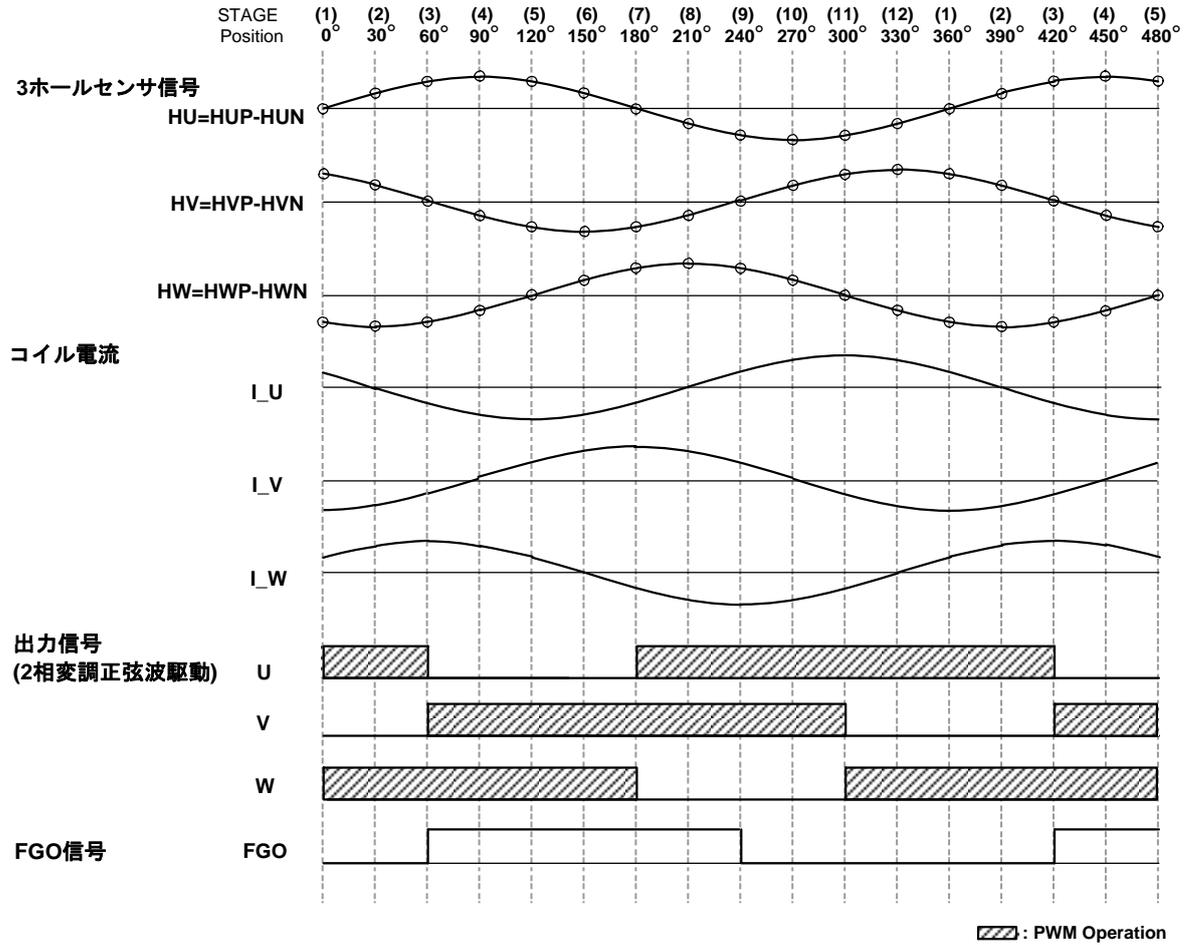


Figure 2. 正弦波駆動タイミングチャート(FR=Low)

ホールセンサの調整について

ホールセンサを使用した場合、安定した駆動のためにはホール信号の振幅調整が重要となります。正常なモータの位置検出を行うためにホール入力ヒスレベル+ (V_{HYSP})、ホール入力ヒスレベル- (V_{HYSN})より十分大きなホール信号の振幅が必要となります。ホール素子、ホールICの選定は感度、温度特性を十分考慮する必要があります。

1. タイミングチャート — 続き

1.2 通電ロジック

FR=High(U→V→W、進角 0°時)

Table 4. 通電ロジック表

STAGE	入力条件			出力状態		
	HU =(HUP)-(HUN)	HV =(HVP)-(HVN)	HW =(HWP)-(HWN)	U	V	W
1	Middle	Low	High	PWM	Low	PWM
2	High	Low	High	PWM	Low	PWM
3	High	Low	Middle	PWM	Low~PWM	PWM~Low
4	High	Low	Low	PWM	PWM	Low
5	High	Middle	Low	PWM	PWM	Low
6	High	High	Low	PWM	PWM	Low
7	Middle	High	Low	PWM~Low	PWM	Low~PWM
8	Low	High	Low	Low	PWM	PWM
9	Low	High	Middle	Low	PWM	PWM
10	Low	High	High	Low	PWM	PWM
11	Low	Middle	High	Low~PWM	PWM~Low	PWM
12	Low	Low	High	PWM	Low	PWM

2. ロック保護機能 (MLP: Motor Lock Protection)

モータが外乱要因などでロックした場合、出力電流を流し続けることがないように一定時間 (ロック保護時間 t_{LK_PRT} : 5.0 s [Typ])外付け FET 出力を全相 OFF させます。また、その後自動復帰する機能を有しています。モータが回転している場合はホール信号の切替りを検出しますが、モータがロックした場合はホール信号の切替りは検出されません。一定時間 (ロック保護検出時間 t_{LK_DET} : 0.5 s [Typ])、ホール信号の切替りが検出されなかった場合、モータがロックしたと判断します。モータロック時のホール信号及び各出力相のタイミングチャートを Figure 3 に示します。

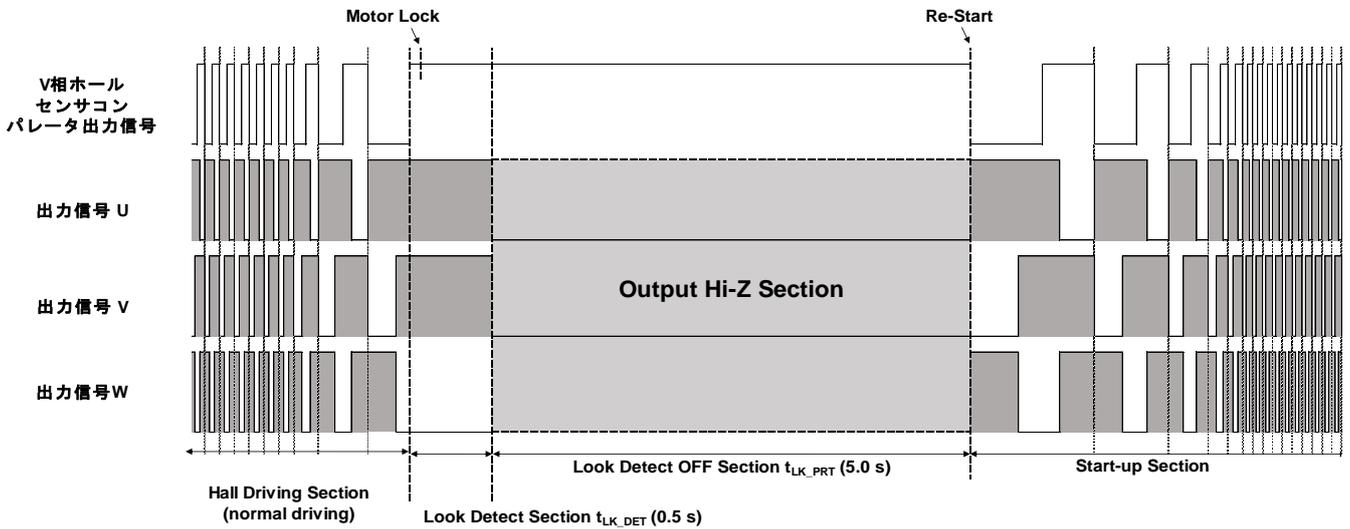


Figure 3. ロック保護時のタイミングチャート

動作説明 — 続き

3. カレントリミット設定 (RCL 端子)

設定電流値以上のコイル電流を検出すると上側出力を全相 OFF させ電流を遮断します。上側出力を全相 OFF させた後、次の PWM (ON)のタイミングで電流が設定電流値を下回った場合、通常駆動に戻ります。カレントリミットが動作する設定電流値 I_o は IC 内部のカレントリミット設定電圧 (V_{CL})0.2 V (Typ)とコイル電流検出に使用する抵抗 R_1 で決まります。以下に例として $R_1=0.2 \Omega$ の場合の式を示します。

$$\begin{aligned} I_o [A] &= V_{CL} [V] / R_1 [\Omega] \\ &= 0.2 / 0.2 \\ &= 1.0 A \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} P_C [W] &= V_{CL} [V] \times I_o [A] \\ &= 0.2 \times 1.0 \\ &= 0.2 W \end{aligned}$$

カレントリミット機能を使用しない場合、RCL 端子は GND とショートしてください。コイル電流検出に使用する抵抗 R_1 は大電流が流れます。消費電力 P_C は上記に示す式で計算となりますので、許容損失に注意してください。

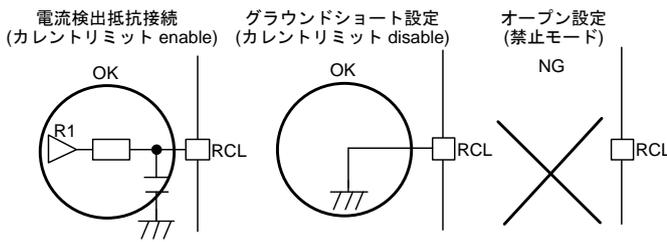


Figure 4. RCL 端子処理

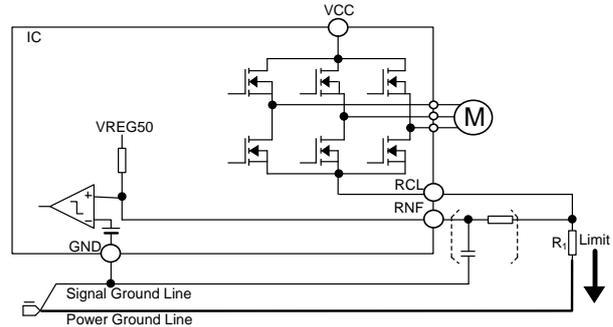


Figure 5. 小信号と大電流グラウンドライン分離

PCB レイアウト設計時は Figure 5 に示すように、IC 小信号グラウンドラインは R_1 が接続されるモータ大電流グラウンドラインとは分離してください。

4. ソフトスタート時間設定 (SS_SEL 端子)

モータ停止状態から起動する際に、突入電流を抑制するためにコイル電流を徐々に上げる機能 (ソフトスタート機能)があります。モータ停止状態から起動する起動指令には、電源投入による起動、トルク入力による起動 (PWMB 端子)、パワーセーブ解除による起動 (PS 端子)、ロック保護からの復帰、回転方向切替え時のショートブレーキモードからの復帰 (FR 端子)、及び各保護回路 (高速回転保護、過電圧保護、低電圧保護、過熱保護)によりモータが停止した状態からの復帰があります。ソフトスタート時のカレントリミットについては、出力 Duty を徐々に上げていくことで正弦波駆動を維持します。



Figure 6. ソフトスタート時のコイル電流波形のタイミングチャート

4. ソフトスタート時間設定 (SS_SEL 端子) — 続き

ソフトスタート機能は、IC 内部のカレントリミット設定電圧を徐々に上げることで実現します。ソフトスタートの 1 ステップ時間は、Table 5 に示すように SS_SEL 端子の電圧により設定します。また、1 ステップ時間は±10%のバラツキがあることを考慮して設定してください。IC 内部のカレントリミット設定電圧は、1 ステップ電圧 5.16 mV (Typ)上昇します。したがって、ソフトスタート時間は下記のように計算できます。

$$\text{ソフトスタート時間} = 1 \text{ ステップ時間} \times (V_{CL} - 51.6 \text{ mV}) / 5.16 \text{ mV}$$

例えば、SS_SEL=0 V に設定した場合、

$$\text{ソフトスタート時間} = 49 \text{ ms} \times (200 \text{ mV} - 51.6 \text{ mV}) / 5.16 \text{ mV} = 1.4 \text{ s}$$

となります。

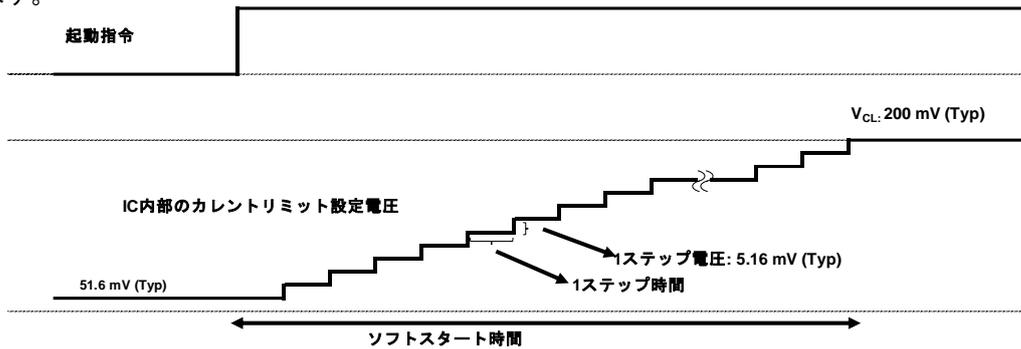


Figure 7. ソフトスタート時のカレントリミット設定電圧のタイミングチャート

Table 5. SS_SEL 端子設定表

SS_SEL 端子設定				1 ステップ時間 (Typ)		
0.000	x	V _{VREG50}	~ 0.056	x	V _{VREG50}	49 ms
0.069	x	V _{VREG50}	~ 0.119	x	V _{VREG50}	98 ms
0.131	x	V _{VREG50}	~ 0.181	x	V _{VREG50}	147 ms
0.194	x	V _{VREG50}	~ 0.244	x	V _{VREG50}	197 ms
0.256	x	V _{VREG50}	~ 0.306	x	V _{VREG50}	246 ms
0.319	x	V _{VREG50}	~ 0.369	x	V _{VREG50}	295 ms
0.381	x	V _{VREG50}	~ 0.431	x	V _{VREG50}	344 ms
0.444	x	V _{VREG50}	~ 0.494	x	V _{VREG50}	393 ms
0.506	x	V _{VREG50}	~ 0.556	x	V _{VREG50}	442 ms
0.569	x	V _{VREG50}	~ 0.619	x	V _{VREG50}	491 ms
0.631	x	V _{VREG50}	~ 0.681	x	V _{VREG50}	541 ms
0.694	x	V _{VREG50}	~ 0.744	x	V _{VREG50}	590 ms
0.756	x	V _{VREG50}	~ 0.806	x	V _{VREG50}	639 ms
0.819	x	V _{VREG50}	~ 0.869	x	V _{VREG50}	688 ms
0.881	x	V _{VREG50}	~ 0.931	x	V _{VREG50}	737 ms
0.944	x	V _{VREG50}	~ 1.000	x	V _{VREG50}	786 ms

動作説明 — 続き

5. モータ極数設定 (POLE_SEL 端子)

POLE_SEL 端子の電圧はモータ極数に合わせた設定にしてください。設定は Table 6 を参照してください。その他の極数については、アプリケーションノートを参照してください。

Table 6. POLE_SEL 端子設定表

POLE_SEL 端子設定						モータ極数 (極)	
0.00	X	V _{VREG50}	~	0.13	X	V _{VREG50}	4
0.16	X	V _{VREG50}	~	0.27	X	V _{VREG50}	6
0.30	X	V _{VREG50}	~	0.41	X	V _{VREG50}	8
0.44	X	V _{VREG50}	~	0.56	X	V _{VREG50}	2
0.59	X	V _{VREG50}	~	0.70	X	V _{VREG50}	12
0.73	X	V _{VREG50}	~	0.84	X	V _{VREG50}	14
0.87	X	V _{VREG50}	~	1.00	X	V _{VREG50}	10

6. 低電圧保護 (UVLO: Under Voltage Lock Out)

通常動作から逸脱するような極めて低い電源電圧域にて、IC が意図的に出力をすべて OFF させることにより、駆動 MOS に大電流が流れるなどの想定外の動作を防ぐための保護機能です。推奨動作電源電圧 8 V 未満の領域では、電源電圧が 6 V (Typ) 以下になると低電圧保護回路が作動し、出力はすべて OFF します。さらにレギュレータ出力 (VREG50、VREG15) が OFF します。低電圧保護回路にはヒステリシス幅が 1 V (Typ) あり、電源電圧が 7 V (Typ) 以上になると低電圧保護が解除となります。

7. VG 低電圧保護 (VG UVLO)

V_G が V_{CC}+3.0 V (Typ) 以下になると VG UVLO 回路が作動し、出力はすべて OFF します。VG UVLO 回路にはヒステリシスを設けていません。

8. 過電圧保護 (OVLO: Over Voltage Lock Out)

電源電圧が 31 V (Typ) 以上になると過電圧保護が作動し、一定時間 (保護時間 t_{LK_PRT}: 5.0 s [Typ]) ショートブレーキ動作になり、すべての出力を Low にします。また VG 電圧用の昇圧機能が OFF します。過電圧保護回路にはヒステリシス幅が 1 V (Typ) あり、保護時間後に電源電圧が 30 V (Typ) 以下になると過電圧保護が解除されます。なお、誤動作防止のため、4 μs (Typ) のマスク時間を設けております。

9. 高速回転保護

モータが制御不能などにより回転速度上昇が起きる場合に対して、出力電流を流し続けることがないように、40,300 rpm (Typ) 以上になると高速回転保護が作動し、一定時間 (保護時間 t_{LK_PRT}: 5.0 s [Typ]) 出力はすべて OFF します。保護時間後に 40,300 rpm (Typ) 未満になると高速回転保護は解除されます。

10. 過熱保護 (TSD : Thermal Shut Down)

チップ温度が 175 °C (Typ) 以上になると過熱保護が作動し、一定時間 (保護時間 t_{LK_PRT}: 5.0 s [Typ]) 出力はすべて OFF します。過熱保護回路にはヒステリシス幅が 25 °C (Typ) あり、保護時間後にチップ温度が下がると過熱保護が解除されます。なお、過熱保護回路はあくまでも熱的暴走から本 IC を遮断することを目的とした回路であり、この回路が動作する時点で動作温度保証範囲を超えています。したがって、この回路を動作させて以降の連続使用、及び動作を前提とした使用にならないよう、十分マージンを持った熱設計をしてください。

動作説明 — 続き

11. 過電流保護 (OCP: Over Current Protection)

出力端子間のショートや出力端子の天絡・地絡時の破壊対策として、過電流保護回路を内蔵しています。規定の電流以上になると過電流保護が作動し、一定時間 (保護時間 t_{LK_PRT} : 5.0 s [Typ])出力はすべて OFF します。保護時間後に過電流が検出されないと過電流保護は解除されます。しかし、この回路が動作する時点で出力電流定格を超えています。したがって、この回路を動作させて以降の連続使用、及び動作を前提とした使用にならないよう、十分マージンを持った設計をしてください。

12. ホール入力異常保護(Hall Error)

ホール入力に異常になった場合、ホール入力異常保護回路が作動し、出力はすべて OFF します。保護機能にはマスク時間 1.0 ms (Typ)が設けられております。保護がかかると、パワーセーブ、速度指令未入力、または電源オフからの再スタートにより解除されるまで、保護動作を続けます。

13. 保護動作の優先順位

保護動作中にその保護動作より優先順位が高い保護動作がかかった場合、優先順位の高い保護動作を行います。それぞれの保護動作には優先順位があり、以下のように設定しています。

Table 7. 保護動作の優先順位表

優先順位	保護動作の種類
1st	VCC UVLO
2nd	OCP
3rd	TSD
4th	OVLO
5th	ロック保護、高速回転保護、 ホール入力異常保護、VG UVLO

14. 自動進角制御

モータ駆動中、コイルに発生する逆起電圧の位相とコイル電流の位相を自動的に一致させることで、高効率駆動を可能にする自動進角機能を搭載しています。そのためには、進角 0°時のホールセンサ信号とコイル電流のタイミングが Figure 1 (U→V→W)または Figure 2 (U→W→V)となるように、Figure 8 を参考にしてホールセンサを配置してください。進角調整範囲は 0° ~ 45°となります。

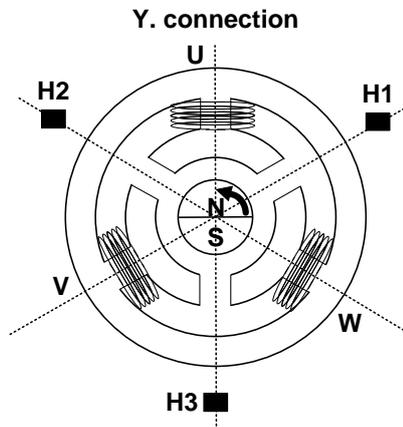


Figure 8. ホールセンサの配置

動作説明 — 続き

15. 速度フィードバック制御

モータの回転数を一定に保つ速度フィードバック制御を搭載しています。PWMB 端子によって設定した目標回転数とモータを駆動して検出された内部基準 FG 信号の周波数が等しくなるように駆動 Duty を制御します。設定回転数やモータの特性に合わせて各種パラメータを設定し、そのパラメータを OTP に書き込むことができます。IC 電源投入時に、OTP に書き込まれたデータがレジスタに設定されます。OTP にデータが書き込まれていない状態では、レジスタ初期値で動作します。OTP への設定方法についてはアプリケーションノートを参照してください。ここでは、レジスタ初期値での動作について説明します。速度フィードバック制御ブロックの構成図を Figure 9 に示します。

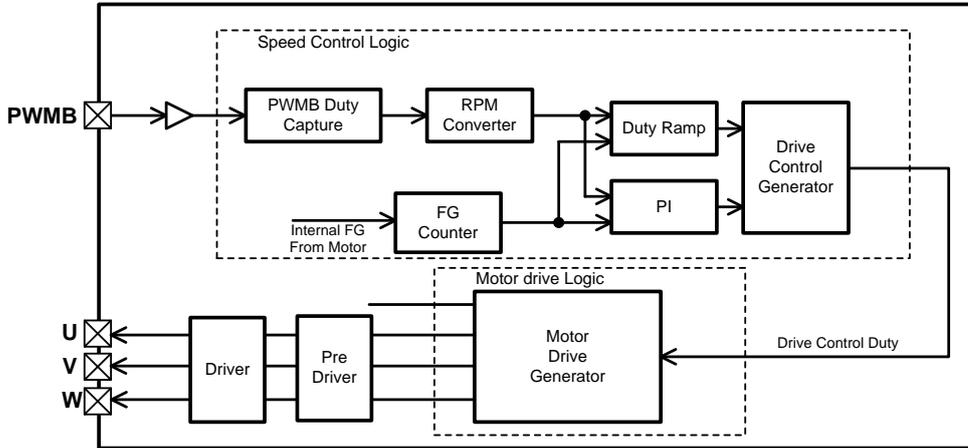


Figure 9. 速度フィードバック制御ブロック図

15.1 PWMB Duty と目標回転数の関係

入力 PWMB Duty に対する目標回転数は、POLE_SEL が 10 極設定の場合、Figure 10 となります。モータ極数と PWMB Duty=0 %時 (負論理であることに注意)の最大目標回転数 Target RPM (Max)の関係は

$$Target\ RPM\ (Max) = 1,024 \times (80 + 1) \times 0.256 \times \frac{4}{poles}$$

となります。10 極モータの場合は次のようになります。

$$\begin{aligned} Target\ RPM\ (Max) &= 1,024 \times (80 + 1) \times 0.256 \times \frac{4}{10} \\ &= 8493\ rpm \end{aligned}$$

また、目標回転数の設定を 84.9 rpm 以下 (PWMB Duty 99 %以上)に設定した場合に駆動オフ判定となりモータをストップ (Hi-z 出力)する機能を搭載しています。また 424.6 rpm 以上 (PWMB Duty 95 %以下)に設定したタイミングでモータを再起動させます。

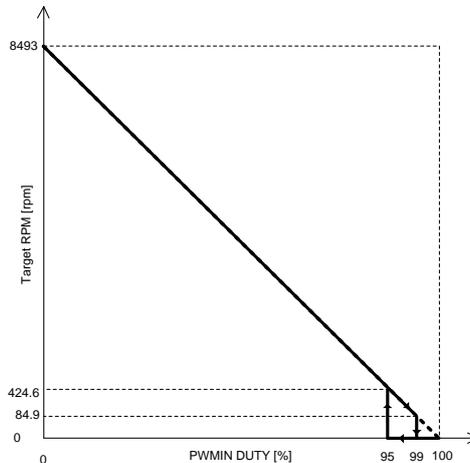


Figure 10. PWMB Duty と目標回転数 (10 極設定)

15. 速度フィードバック制御 — 続き

15.2 モータ回転数測定

モータ回転数として、内部 FG 信号の半周期を測定します。その測定値を、目標回転数から計算される目標周期の半周期と比較し、その差分を速度エラー値とします。内部 FG 信号の半周期が長い (目標回転数より遅い) 場合、速度エラー値はマイナスの値をとります。逆に短い (目標回転数より速い) 場合、速度エラー値はプラスの値をとります。

15.3 モータ速度制御設定

RAMP 制御駆動と PI 制御駆動で駆動します。モータ速度制御設定を Table 8 に示します。

Table 8. モータ速度制御設定表

起動・加減速動作	定常動作
RAMP 制御駆動	PI 制御駆動

15.4 PI 制御

PI 制御を用いたクローズドループ速度フィードバック制御を行います。駆動制御 Duty (Drive Control) は内部基準 FG 信号周期計測で計測した速度エラー値 (Error Value) に対して比例ゲイン ($K_P=1.0$)、積分ゲイン ($K_I=0.0117$) から算出されます。Figure 11 に PI 制御ブロック図を示します。

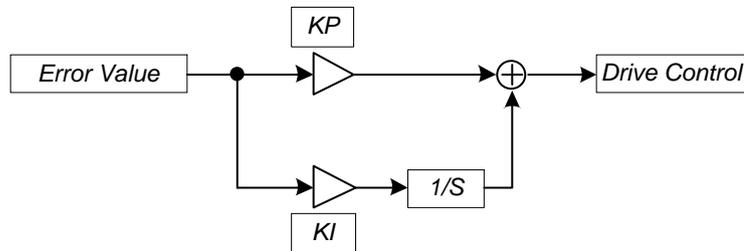


Figure 11. PI 制御ブロック図

15. 速度フィードバック制御 — 続き

15.5 RAMP 制御

速度エラー値がマイナス (目標回転数より遅い) の場合は駆動制御 Duty を徐々に増加させ、プラス (目標回転数より速い) の場合は徐々に減少させて実際のモータ回転数が目標回転数に近づきます。Figure 13 に示すように、41.6 ms 毎に 0.49 % Duty が変化します。

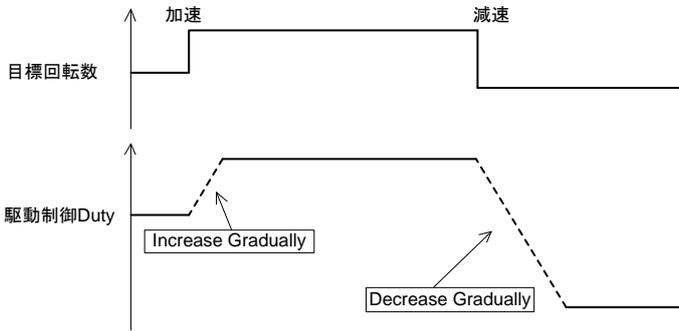


Figure 12. RAMP 制御機能概要

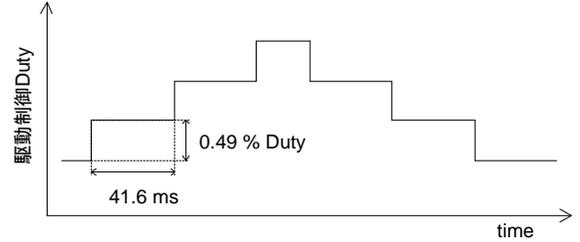


Figure 13. RAMP Step

RAMP 制御から PI 制御への切替えは目標回転数に対する速度エラー値が 1.57 % 以内に収まると PI 制御に移行します。速度エラー値の大きい領域では、実際のモータ回転数は RAMP 制御を行い目標回転数に近づきます。速度エラー値が小さくなると PI 制御を開始することでパラメータ調整を容易にします。

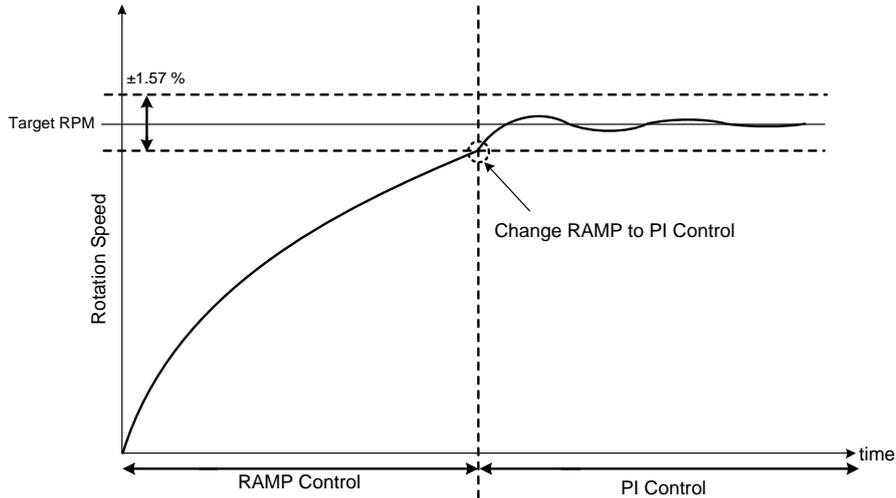


Figure 14. RAMP 制御から PI 制御へ移行する動作

熱抵抗モデル

ICが電力を消費することにより発生する熱は、パッケージのモールド樹脂やリードフレームなどから放熱されます。この放熱性（熱の逃げにくさ）を示すパラメータは熱抵抗と呼ばれます。また、チップ接合部から周囲温度までの熱抵抗は θ_{JA} ($^{\circ}\text{C}/\text{W}$)、チップ接合部からパッケージ上面中心までの熱抵抗パラメータは ψ_{JT} ($^{\circ}\text{C}/\text{W}$)で表されます。熱抵抗はパッケージ部と基板部に分かれ、パッケージ部の熱抵抗は、モールド樹脂やリードフレームなどの構成材料に依存し、一方、基板部の熱抵抗は、材質、大きさ、銅箔面積などの基板放熱性に依存します。したがって、実装基板にヒートシンクなどを装着する放熱対策により熱抵抗を低減できます。以下に熱抵抗算出式を、Figure 15に熱抵抗モデルを示します。

計算式

$$\theta_{JA} = \frac{Tj - Ta}{P} \text{ [}^{\circ}\text{C}/\text{W}]$$

$$\psi_{JT} = \frac{Tj - Tt}{P} \text{ [}^{\circ}\text{C}/\text{W}]$$

θ_{JA} : 接合部から周囲環境までの熱抵抗 ($^{\circ}\text{C}/\text{W}$)

ψ_{JT} : 接合部からパッケージ上面中心までの熱特性パラメータ ($^{\circ}\text{C}/\text{W}$)

Tj : 接合部温度 ($^{\circ}\text{C}$)

Ta : 周囲温度 ($^{\circ}\text{C}$)

Tt : パッケージ上面中心温度 ($^{\circ}\text{C}$)

P : 消費電力 (W)

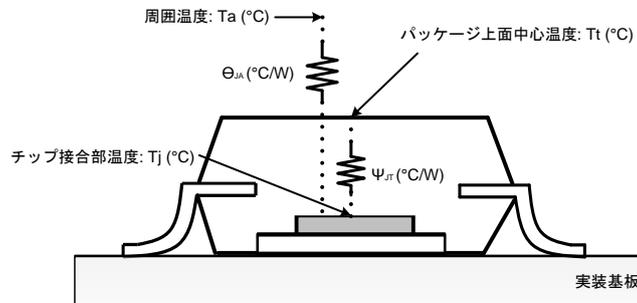
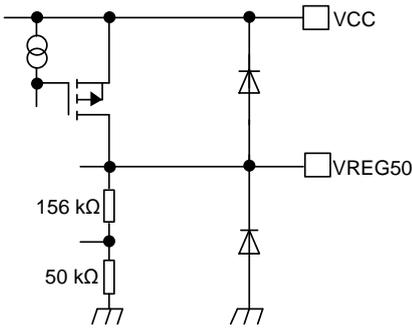


Figure 15. 表面実装パッケージの熱抵抗モデル

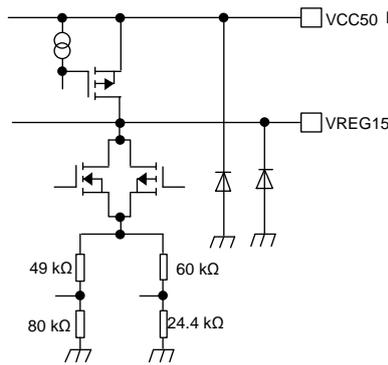
θ_{JA} , ψ_{JT} は、同一パッケージを使用しても搭載ICのチップサイズや消費電力、並びに周囲温度、実装条件、風速などの測定環境により変化します。

入出力等価回路図

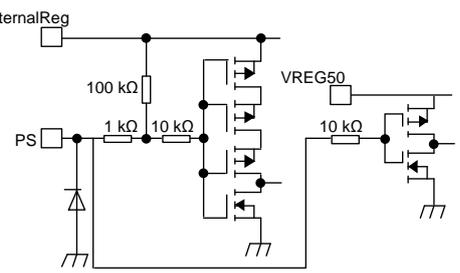
1) VREG50 pin



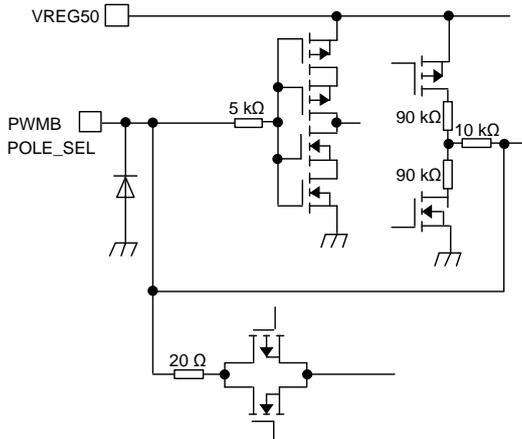
2) VREG15 pin



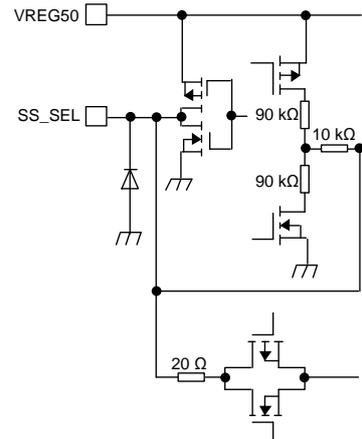
3) PS pin



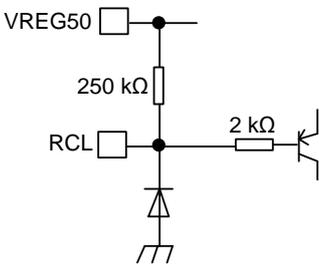
4) PWMB, POLE_SEL pin



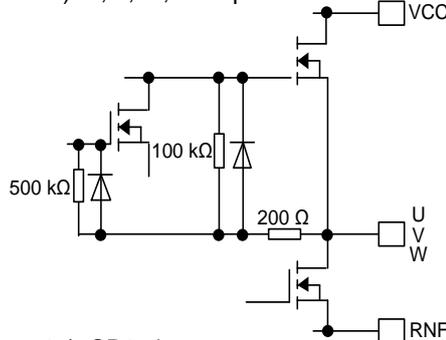
5) SS_SEL pin



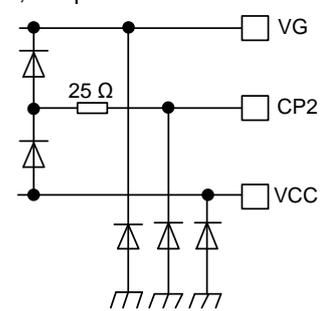
6) RCL pin



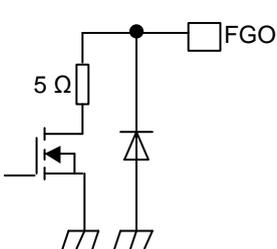
7) U, V, W, RNF pin



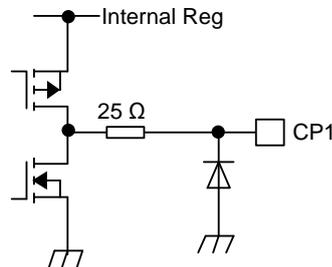
8) CP2, VG pin



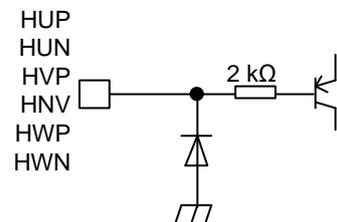
9) FGO pin



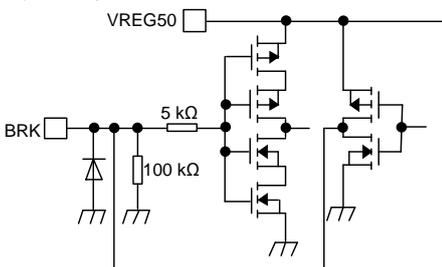
10) CP1 pin



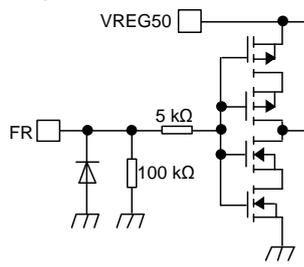
11) HUP, HUN, HVP, HVN, HWP, HWN



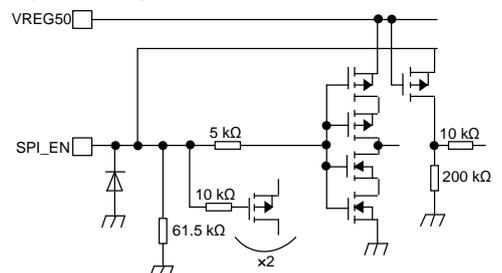
12) BRK pin



13) FR pin



14) SPL_EN pin



使用上の注意

1. 電源の逆接続について

電源コネクタの逆接続により LSI が破壊する恐れがあります。逆接続破壊保護用として外部に電源と LSI の電源端子間にダイオードを入れるなどの対策を施してください。

2. 電源ラインについて

基板パターンの設計においては、電源ラインの配線は、低インピーダンスになるようにしてください。グラウンドラインについても、同様のパターン設計を考慮してください。また、LSI のすべての電源端子について電源-グラウンド端子間にコンデンサを挿入するとともに、電解コンデンサ使用の際は、低温で容量低下が起こることなど使用するコンデンサの諸特性に問題ないことを十分ご確認のうえ、定数を決定してください。

3. グラウンド電位について

L 負荷駆動端子（例：モータドライバの出力、DC-DC コンバータの出力など）については、L 負荷の逆起電圧の影響でグラウンド以下に振れることが考えられます。L 負荷駆動端子が逆起電圧によって負電位になる場合を除き、グラウンド端子はいかなる動作状態においても最低電位になるようにしてください。また実際に過渡現象を含め、グラウンド端子、L 負荷駆動端子以外のすべての端子がグラウンド以下の電圧にならないようにしてください。使用条件、環境及び L 負荷個々の特性によっては誤動作などの不具合が発生する可能性があります。IC の動作などに問題のないことを十分ご確認ください。

4. グラウンド配線パターンについて

小信号グラウンドと大電流グラウンドがある場合、大電流グラウンドパターンと小信号グラウンドパターンは分離し、パターン配線の抵抗分と大電流による電圧変化が小信号グラウンドの電圧を変化させないように、セットの基準点で 1 点アースすることを推奨します。外付け部品のグラウンドの配線パターンも変動しないよう注意してください。グラウンドラインの配線は、低インピーダンスになるようにしてください。

5. 推奨動作条件について

推奨動作条件で規定される範囲で IC の機能・動作を保証します。また、特性値は電気的特性で規定される各項目の条件下においてのみ保証されます。

6. ラッシュカレントについて

IC 内部論理回路は、電源投入時に論理不定状態で、瞬間的にラッシュカレントが流れる場合がありますので、電源カップリング容量や電源、グラウンドパターン配線の幅、引き回しに注意してください。

7. セット基板での検査について

セット基板での検査時に、インピーダンスの低いピンにコンデンサを接続する場合は、IC にストレスがかかる恐れがあるので、1 工程ごとに必ず放電を行ってください。静電気対策として、組立工程にはアースを施し、運搬や保存の際には十分ご注意ください。また、検査工程での治具への接続をする際には必ず電源を OFF にしてから接続し、電源を OFF にしてから取り外してください。

8. 端子間ショートと誤装着について

プリント基板に取り付ける際、IC の向きや位置ずれに十分注意してください。誤って取り付けた場合、IC が破壊する恐れがあります。また、出力と電源及びグラウンド間、出力間に異物が入るなどしてショートした場合についても破壊の恐れがあります。

9. 未使用の入力端子の処理について

CMOS トランジスタの入力は非常にインピーダンスが高く、入力端子をオープンにすることで論理不定の状態になります。これにより内部の論理ゲートの p チャネル、n チャネルトランジスタが導通状態となり、不要な電源電流が流れます。また論理不定により、想定外の動作をすることがあります。よって、未使用の端子は特に仕様書上でうたわれていない限り、適切な電源、もしくはグラウンドに接続するようにしてください。

使用上の注意 — 続き

10. 各入力端子について

本 IC は、各素子間に素子分離のための P+アイソレーションと、P 基板を有しています。この P 層と各素子の N 層とで P-N 接合が形成され、各種の寄生素子が構成されます。例えば、下図のように、抵抗とトランジスタが端子と接続されている場合、

- 抵抗では、GND > (端子 A)の時、トランジスタ(NPN)では GND > (端子 B)の時、P-N 接合が寄生ダイオードとして動作します。
- また、トランジスタ(NPN)では、GND > (端子 B)の時、前述の寄生ダイオードと近接する他の素子の N 層によって寄生の NPN トランジスタが動作します。

IC の構造上、寄生素子は電位関係によって必然的にできます。寄生素子が動作することにより、回路動作の干渉を引き起こし、誤動作、ひいては破壊の原因ともなり得ます。したがって、入出力端子に GND(P 基板)より低い電圧を印加するなど、寄生素子が動作するような使い方をしないよう十分に注意してください。アプリケーションにおいて電源端子と各端子電圧が逆になった場合、内部回路または素子を損傷する可能性があります。例えば、外付けコンデンサに電荷がチャージされた状態で、電源端子が GND にショートされた場合などです。また、電源端子直列に逆流防止のダイオードもしくは各端子と電源端子間にバイパスのダイオードを挿入することを推奨します。

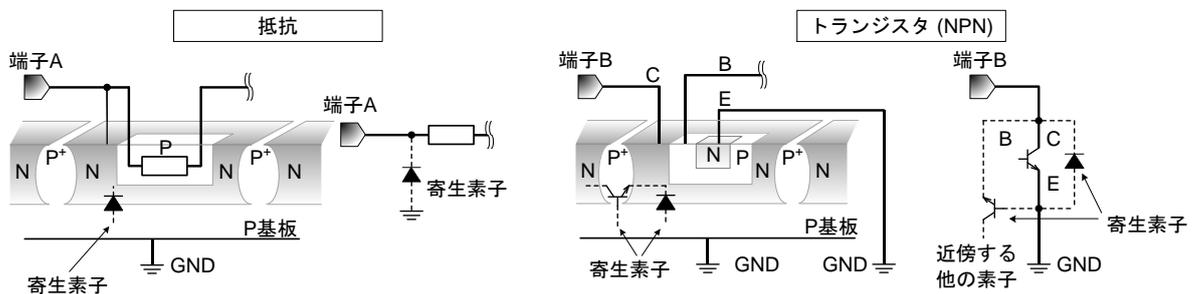


Figure 16. IC 構造例

11. セラミック・コンデンサの特性変動について

外付けコンデンサに、セラミック・コンデンサを使用する場合、直流バイアスによる公称容量の低下、及び温度などによる容量の変化を考慮のうえ定数を決定してください。

12. 温度保護回路について

IC を熱破壊から防ぐための温度保護回路を内蔵しております。最高接合部温度内でご使用いただきますが、万が一最高接合部温度を超えた状態が継続すると、温度保護回路が動作し出力パワー素子が OFF します。その後チップ温度 T_j が低下すると回路は自動で復帰します。なお、温度保護回路は絶対最大定格を超えた状態での動作となりますので、温度保護回路を使用したセット設計などは、絶対に避けてください。

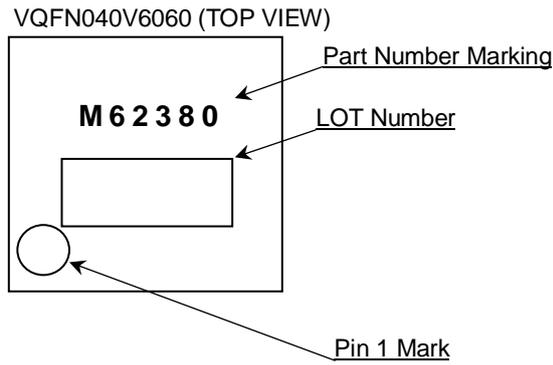
13. 過電流保護回路について

出力には電流能力に応じた過電流保護回路が内部に内蔵されているため、負荷ショート時には IC 破壊を防止しますが、この保護回路は突発的な事故による破壊防止に有効なもので、連続的な保護回路動作、過渡時でのご使用に対応するものではありません。

発注形名情報

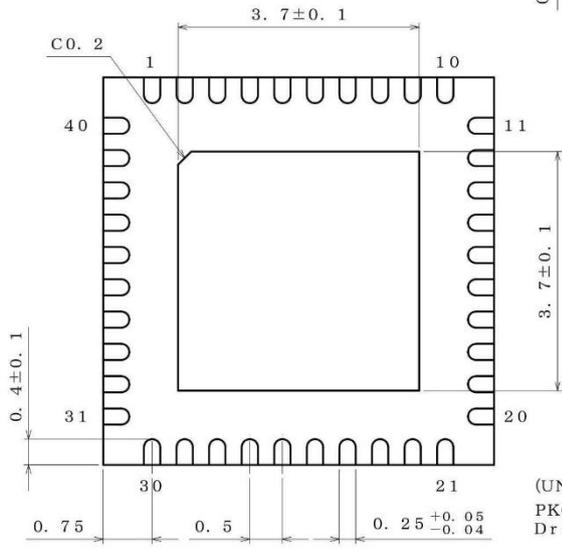
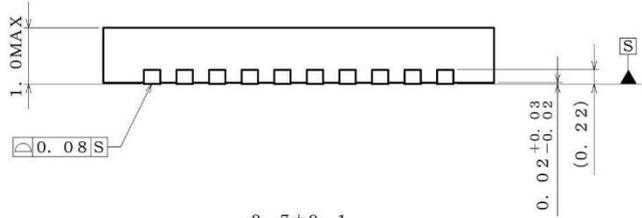
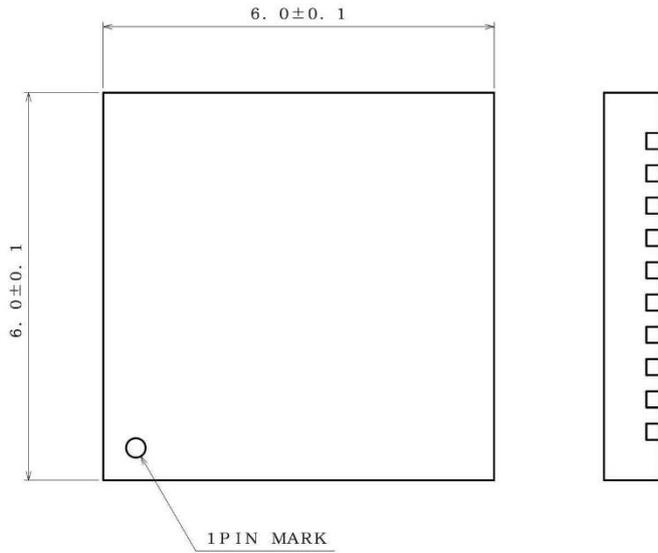


標印図



外形寸法図と包装・フォーミング仕様

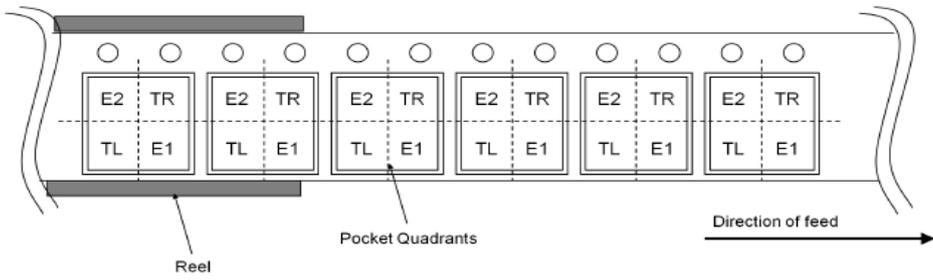
Package Name	VQFN040V6060
--------------	--------------



(UNIT: mm)
 PKG: VQFN040V6060
 Drawing No. EX464-5001-1

<包装仕様>

包装形態	エンボステーピング
包装数量	2000pcs
包装方向	E2 (リールを左手に持ち、右手でテープを引き出したときに 製品の1番ピンが左上にくる方向)



改訂履歴

日付	版	変更内容
2019.03.18	001	新規作成

ご注意

ローム製品取扱い上の注意事項

1. 本製品は一般的な電子機器（AV 機器、OA 機器、通信機器、家電製品、アミューズメント機器等）への使用を意図して設計・製造されております。したがって、極めて高度な信頼性が要求され、その故障や誤動作が人の生命、身体への危険もしくは損害、又はその他の重大な損害の発生に関わるような機器又は装置（医療機器^(Note 1)、輸送機器、交通機器、航空宇宙機器、原子力制御装置、燃料制御、カーアクセサリを含む車載機器、各種安全装置等）（以下「特定用途」という）への本製品のご使用を検討される際は事前にローム営業窓口までご相談くださいますようお願い致します。ロームの文書による事前の承諾を得ることなく、特定用途に本製品を使用したことによりお客様又は第三者に生じた損害等に関し、ロームは一切その責任を負いません。

(Note 1) 特定用途となる医療機器分類

日本	USA	EU	中国
CLASS III	CLASS III	CLASS II b	Ⅲ類
CLASS IV		CLASS III	

2. 半導体製品は一定の確率で誤動作や故障が生じる場合があります。万が一、かかる誤動作や故障が生じた場合であっても、本製品の不具合により、人の生命、身体、財産への危険又は損害が生じないように、お客様の責任において次の例に示すようなフェールセーフ設計など安全対策をお願い致します。
 - ①保護回路及び保護装置を設けてシステムとしての安全性を確保する。
 - ②冗長回路等を設けて単一故障では危険が生じないようにシステムとしての安全を確保する。
3. 本製品は、一般的な電子機器に標準的な用途で使用されることを意図して設計・製造されており、下記に例示するような特殊環境での使用を配慮した設計はなされておられません。したがって、下記のような特殊環境での本製品のご使用に関し、ロームは一切その責任を負いません。本製品を下記のような特殊環境でご使用される際は、お客様におかれまして十分に性能、信頼性等をご確認ください。
 - ①水・油・薬液・有機溶剤等の液体中でのご使用
 - ②直射日光・屋外暴露、塵埃中でのご使用
 - ③潮風、Cl₂、H₂S、NH₃、SO₂、NO₂等の腐食性ガスの多い場所でのご使用
 - ④静電気や電磁波の強い環境でのご使用
 - ⑤発熱部品に近接した取付け及び当製品に近接してビニール配線等、可燃物を配置する場合。
 - ⑥本製品を樹脂等で封止、コーティングしてのご使用。
 - ⑦はんだ付けの後に洗浄を行わない場合(無洗浄タイプのフラックスを使用される場合は除く。ただし、残渣については十分に確認をお願いします。)又は、はんだ付け後のフラックス洗浄に水又は水溶性洗浄剤をご使用の場合
 - ⑧本製品が結露するような場所でのご使用。
4. 本製品は耐放射線設計はなされておられません。
5. 本製品単体品の評価では予測できない症状・事態を確認するためにも、本製品のご使用にあたってはお客様製品に実装された状態での評価及び確認をお願い致します。
6. パルス等の過渡的な負荷（短時間での大きな負荷）が加わる場合は、お客様製品に本製品を実装した状態で必ずその評価及び確認の実施をお願い致します。また、定常時での負荷条件において定格電力以上の負荷を印加されますと、本製品の性能又は信頼性が損なわれるおそれがあるため必ず定格電力以下でご使用ください。
7. 電力損失は周囲温度に合わせてディレーティングしてください。また、密閉された環境下でご使用の場合は、必ず温度測定を行い、最高接合部温度を超えていない範囲であることをご確認ください。
8. 使用温度は納入仕様書に記載の温度範囲内であることをご確認ください。
9. 本資料の記載内容を逸脱して本製品をご使用されたことによって生じた不具合、故障及び事故に関し、ロームは一切その責任を負いません。

実装及び基板設計上の注意事項

1. ハロゲン系（塩素系、臭素系等）の活性度の高いフラックスを使用する場合、フラックスの残渣により本製品の性能又は信頼性への影響が考えられますので、事前にお客様にてご確認ください。
2. はんだ付けは、表面実装製品の場合リフロー方式、挿入実装製品の場合フロー方式を原則とさせていただきます。なお、表面実装製品をフロー方式での使用をご検討の際は別途ロームまでお問い合わせください。その他、詳細な実装条件及び手はんだによる実装、基板設計上の注意事項につきましては別途、ロームの実装仕様書をご確認ください。

応用回路、外付け回路等に関する注意事項

1. 本製品の外付け回路定数を変更してご使用になる際は静特性のみならず、過渡特性も含め外付け部品及び本製品のバラツキ等を考慮して十分なマージンをみて決定してください。
2. 本資料に記載された応用回路例やその定数などの情報は、本製品の標準的な動作や使い方を説明するためのもので、実際に使用する機器での動作を保証するものではありません。したがって、お客様の機器の設計において、回路やその定数及びこれらに関連する情報を使用する場合には、外部諸条件を考慮し、お客様の判断と責任において行ってください。これらの使用に起因しお客様又は第三者に生じた損害に関し、ロームは一切その責任を負いません。

静電気に対する注意事項

本製品は静電気に対して敏感な製品であり、静電放電等により破壊することがあります。取り扱い時や工程での実装時、保管時において静電気対策を実施のうえ、絶対最大定格以上の過電圧等が印加されないようにご使用ください。特に乾燥環境下では静電気が発生しやすくなるため、十分な静電対策を実施ください。(人体及び設備のアース、帯電物からの隔離、イオナイザの設置、摩擦防止、温湿度管理、はんだごてのこて先のアース等)

保管・運搬上の注意事項

1. 本製品を下記の環境又は条件で保管されますと性能劣化やはんだ付け性等の性能に影響を与えるおそれがありますのでこのような環境及び条件での保管は避けてください。
 - ①潮風、Cl₂、H₂S、NH₃、SO₂、NO₂等の腐食性ガスの多い場所での保管
 - ②推奨温度、湿度以外での保管
 - ③直射日光や結露する場所での保管
 - ④強い静電気が発生している場所での保管
2. ロームの推奨保管条件下におきましても、推奨保管期限を経過した製品は、はんだ付け性に影響を与える可能性があります。推奨保管期限を経過した製品は、はんだ付け性を確認したうえでご使用頂くことを推奨します。
3. 本製品の運搬、保管の際は梱包箱を正しい向き(梱包箱に表示されている天面方向)で取り扱ってください。天面方向が遵守されずに梱包箱を落下させた場合、製品端子に過度なストレスが印加され、端子曲がり等の不具合が発生する危険があります。
4. 防湿梱包を開封した後は、規定時間内にご使用ください。規定時間を経過した場合はベーク処置を行ったうえでご使用ください。

製品ラベルに関する注意事項

本製品に貼付されている製品ラベルに2次元バーコードが印字されていますが、2次元バーコードはロームの社内管理のみを目的としたものです。

製品廃棄上の注意事項

本製品を廃棄する際は、専門の産業廃棄物処理業者にて、適切な処置をしてください。

外国為替及び外国貿易法に関する注意事項

本製品は外国為替及び外国貿易法に定める規制貨物等に該当するおそれがありますので輸出する場合には、ロームにお問い合わせください。

知的財産権に関する注意事項

1. 本資料に記載された本製品に関する応用回路例、情報及び諸データは、あくまでも一例を示すものであり、これらに関する第三者の知的財産権及びその他の権利について権利侵害がないことを保証するものではありません。
2. ロームは、本製品とその他の外部素子、外部回路あるいは外部装置等(ソフトウェア含む)との組み合わせに起因して生じた紛争に関して、何ら義務を負うものではありません。
3. ロームは、本製品又は本資料に記載された情報について、ロームもしくは第三者が所有又は管理している知的財産権その他の権利の実施又は利用を、明示的にも黙示的にも、お客様に許諾するものではありません。ただし、本製品を通常の用法にて使用される限りにおいて、ロームが所有又は管理する知的財産権を利用されることを妨げません。

その他の注意事項

1. 本資料の全部又は一部をロームの文書による事前の承諾を得ることなく転載又は複製することを固くお断り致します。
2. 本製品をロームの文書による事前の承諾を得ることなく、分解、改造、改変、複製等しないでください。
3. 本製品又は本資料に記載された技術情報を、大量破壊兵器の開発等の目的、軍事利用、あるいはその他軍事用途目的で使用しないでください。
4. 本資料に記載されている社名及び製品名等の固有名詞は、ローム、ローム関係会社もしくは第三者の商標又は登録商標です。

一般的な注意事項

1. 本製品をご使用になる前に、本資料をよく読み、その内容を十分に理解されるようお願い致します。本資料に記載される注意事項に反して本製品をご使用されたことによって生じた不具合、故障及び事故に関し、ロームは一切その責任を負いませんのでご注意願います。
2. 本資料に記載の内容は、本資料発行時点のものであり、予告なく変更することがあります。本製品のご購入及びご使用に際しては、事前にローム営業窓口で最新の情報をご確認ください。
3. ロームは本資料に記載されている情報は誤りがないことを保証するものではありません。万が一、本資料に記載された情報の誤りによりお客様又は第三者に損害が生じた場合においても、ロームは一切その責任を負いません。